

ACCESSION NUMBER: 2002:378564 CAPLUS
DOCUMENT NUMBER: 136:370472
TITLE: Heat-resistant ion-conductive polyazoles containing
phosphonic acid groups and their electrolyte membranes
INVENTOR(S): Nakao, Junko; Sakaguchi, Yoshimitsu; Kitamura, Kota;
Takase, Satoshi; Hamamoto, Shiro; Tatemori, Hiroshi
PATENT ASSIGNEE(S): Toyobo Co., Ltd., Japan
SOURCE: Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 7 pp.
CODEN: JKXXAF
DOCUMENT TYPE: Patent
LANGUAGE: Japanese
FAMILY ACC. NUM. COUNT: 1
PATENT INFORMATION:

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
JP 2002146014	A2	20020522	JP 2000-348323	20001115
PRIORITY APPLN. INFO.:			JP 2000-348323	20001115

AB The polyazoles with 3% wt. loss temp. (Tw3) 7400? (based on wt. at 200? in TGA measurement), soly. to N-methylpyrrolidone 75%, av. mol. wt. 1,000-1,000,000, and random and/or alternate structures, useful for fuel cells, etc., are manufd. Thus, a membrane of 3,3',4,4'-tetraaminodiphenylsulfone-3,5-dicarboxyphenylphosphonic acid-terephthalic acid copolymer showed Tw3 444?.

B27

3/28/2005

ION-CONDUCTIVE POLYAZOLE CONTAINING PHOSPHONIC ACID GROUP

Patent number: JP2002146014
Publication date: 2002-05-22
Inventor: NAKAO JUNKO; SAKAGUCHI YOSHIMITSU;
KITAMURA KOTA; TAKASE SATOSHI; HAMAMOTO
SHIRO; TACHIMORI HIROSHI
Applicant: TOYO BOSEKI
Classification:
- international: C08G73/06; C08J5/18; C08J5/22; H01B1/06; H01M8/02;
C08L79/04
- european:
Application number: JP20000348323 20001115
Priority number(s): JP20000348323 20001115

Report a data error here

Abstract of JP2002146014

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer material capable of giving a polymer electrolyte which has not only good processability and good durable stability but also excellent ionic conductivity by introducing sulfonic acid groups or phosphonic acid groups into a polyazole-based polymer having excellent heat resistance, excellent mechanical characteristics or the like. **SOLUTION:** This polyazole compound containing phosphonic acid groups is characterized by having a 3 wt.% loss temperature of ≥ 400 deg.C based on the weight of a sample reaching 200 deg.C on the measurement of TGA, having a solubility of ≥ 5 wt.% in NMP, having an average mol.wt. of 1,000 to 1,000,000, and when plural repeating units are contained, they are mainly randomly and/or alternately binding to each other.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-146014
(P2002-146014A)

(43) 公開日 平成14年5月22日 (2002.5.22)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
C 0 8 G 73/06		C 0 8 G 73/06	4 F 0 7 1
C 0 8 J 5/18	CFG	C 0 8 J 5/18	4 J 0 4 3
5/22	1 0 1	5/22	1 0 1 5 G 3 0 1
H 0 1 B 1/06		H 0 1 B 1/06	A 5 H 0 2 6
// H 0 1 M 8/02		H 0 1 M 8/02	P

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 7 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-348323 (P2000-348323)

(22) 出願日 平成12年11月15日 (2000.11.15)

(71) 出願人 000003160

東洋紡績株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

(72) 発明者 中尾 淳子

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 坂口 佳充

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 北村 幸太

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イオン伝導性ホスホン酸含有ポリアゾール

(57) 【要約】

【課題】 耐熱性、機械特性など優れた性質を持つポリアゾール系ポリマーにスルホン酸基またはホスホン酸基を導入することにより、加工性、耐久安定性だけでなくイオン伝導性にも優れた高分子電解質となりうる高分子材料を得る。

【解決手段】 TGA測定における200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400℃以上であり、NMPへの溶解度が5wt%以上であり、平均分子量が1,000から1,000,000の間にあり、繰り返し単位が複数の場合主としてランダムおよび/または交互的に結合していることを特徴とするホスホン酸含有ポリアゾール化合物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 TGA測定における200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400℃以上であり、NMPへの溶解度が5wt%以上であり、平均分子量が1,000から1,000,000の間にあり、繰り返し単位が複数の場合主としてランダムおよび／または交互的に結合していることを特徴とするホスホン酸含有ポリアゾール化合物。

【請求項2】 ポリアゾール構造がポリイミダゾールであることを特徴とする請求項1記載の化合物。

【請求項3】 請求項1乃至請求項2に記載の化合物を主成分とすることを特徴とする成形物。

【請求項4】 請求項1乃至請求項2に記載の化合物を主成分とすることを特徴とする膜。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、耐熱性、力学特性などにおいてきわめて優れた特性を示すポリアゾール系ポリマーの特性を損なうことなく、高分子電解質膜等として利用できるイオン性基含有ポリマーとなるホスホン酸含有ポリアゾール化合物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液体電解質のかわりに高分子固体電解質をイオン伝導体として用いる電気化学的装置の例として、水電解槽や燃料電池を上げることができる。これらに用いられる高分子膜は、カチオン交換膜としてプロトン導電率とともに化学的、熱的、電気化学的および力学的に十分安定なものでなくてはならない。このため、長期にわたり使用できるものとしては、主に米デュボン社製の「ナフィオン（登録商標）」を代表例とするパーフルオロカーボンスルホン酸膜が使用されてきた。しかしながら、100℃を越える条件で運転しようとする、膜の含水率が急激に落ちるほか、膜の軟化も顕著となる。このため、将来が期待されるメタノールを燃料とする燃料電池においては、膜内のメタノール透過による性能低下がおり、十分な性能を発揮することはできない。また、現在主に検討されている水素を燃料として80℃付近で運転する燃料電池においても、膜のコストが高すぎるものが燃料電池技術の確立の障害として指摘されている。

【0003】このような欠点を克服するため、芳香族環含有ポリマーにスルホン酸基を導入した高分子電解質膜が種々検討されている。例えば、ポリアリールエーテルスルホン酸をスルホン化したもの（Journal of Membrane Science, 83, 211(1993)）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）をスルホン化したもの（特開平6-93114）、スルホン化ポリスチレン等である。しかしながら、ポリマーを原料として芳香環上に導入されたスルホン酸基は酸または熱により脱スルホン酸反応が起こりやすく、燃料電池用電解質膜として使用するには耐久性が十分であると

は言えない。

【0004】スルホン酸を含有したポリベンズイミダゾールについては、UnoらのJ. Polym. Sci., Polym. Chem., 15, 1309(1977)における3, 3'-ジアミノベンジンと3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホン酸または4, 6-ジカルボキシ-1, 3-ベンゼンジスルホン酸から合成するものが、USP-5312895では1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラミンと2, 5-ジカルボキシベンゼンスルホン酸を主成分として合成するものが報告されている。後者の報告で述べられているポリマーは、ジメチルスルホキシドへの溶解性が示されているが、前者の報告で述べられているポリマーはジメチルスルホキシドには部分的には溶解するものの、N-メチルピロリドン（NMP）には溶解しない。このように、スルホン酸を含有したポリマーであっても、その溶解性はポリマーごとに異なっており、明確な傾向はとらえられていなかった。また、これらの報告では、電解質膜用途などスルホン酸基が持つ電気化学的特性について顧みられることはなかった。

【0005】一方、ホスホン酸含有の芳香族ポリマーについても、高分子電解質の観点から着目したものはあまりみられない。たとえば、USP5, 498, 784号において4, 4'-(2, 2, 2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン)ビス(2-アミノフェノール)からなるポリベンズオキサゾールにおいて、ジカルボン酸成分の5%～50%を3, 5-ジカルボキシフェニルホスホン酸とするポリマーが報告されている。このポリマーは溶解性が良いことと複合材料としての可能性が着目されているが、電池用途の高分子電解質としては考慮されることはなかった。実際、このポリマーはアルコール溶解性が特徴であり、メタノールを燃料とする燃料電池用の電解質膜と使用することに適さないことは明白である。また、イオン伝導性も低い値しか示さない。他に、特開平11-286545号では、3, 5-ジカルボキシフェニルホスホン酸を始めとする含リンポリアミド共重合体が報告されているが、これもその耐熱性に着目した性質しか調べられていない。このポリマーは燃料電池として使用される酸性化条件では、加水分解が起こり電解質膜として使用することはできない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、これまで高分子電解質として検討されてきたスルホン酸基のかわり、より耐熱性が高いことが期待されるホスホン酸基を耐熱性、機械特性など優れた性質を持つポリアゾール系ポリマーにNMPへの溶解性を引き出す形で導入することにより、加工性、イオン伝導性だけでなく耐久安定性にも優れた高分子電解質となりうる高分子材料を得ることにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、ホスホン酸基を含有しながら一定レベル以上のイオン伝導性を有するとともに、NMPへの溶解性を示す特定のポリアゾール類において、優れた加工性、耐久性を示す高分子電解質を得るに至った。

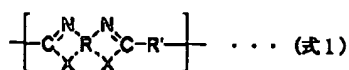
【0008】すなわち本発明は、TGA測定における200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400℃以上であり、NMPへの溶解度が5wt%以上であり、平均分子量が1,000から1,000,000の間にあり、繰り返し単位が複数の場合主としてランダムおよび／または交互的に結合していることを特徴とするホスホン酸含有ポリアゾールである。本発明の成形物とは、高分子化合物の成形方法と同様に処理して得られるものである、即ち重合溶液又は単離したポリマーから押し出し、紡糸、圧延、キャストなどの任意の方法で繊維やフィルムに成形したものである。本発明はこれらの化合物を主成分とすることを特徴とする成形物であり、繊維、フィルム、シート状物などに加工することができ、特に膜にすることにより、特に効果的な性能が発揮される。

【0009】

【発明の実施の形態】以下本発明について詳細に説明する。本発明でいうホスホン酸含有ポリアゾール化合物とはホスホン酸基を含有する芳香族系のポリオキサゾール類、ポリチアゾール類、ポリイミダゾール類およびそれらが混在する組成物や共重合体をさす。一般的には下記式のような繰り返し単位構造で示すことができる。

【0010】

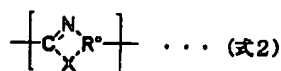
【化1】



(但し、一般式1において、Rはアゾール環を形成できる4価の芳香族基を示し、XはO、S、またはNHを表す。R'は二価の芳香族基、脂肪族基または脂環族基を示し、R'のすべてまたは一部にホスホン酸基を有している。R、R'はいずれも単環であっても、複数の芳香環の結合体、あるいは縮合環であってもよく、ホスホン酸以外の安定な置換基を有していても良い。また、R、R'の芳香環中にN、S、O等が存在するヘテロ環構造を有していてもかまわない)

【0011】また、一般式1とともに下記式で示すような繰り返し単位を含んでいても良い。

【化2】



(ここでXはO、S、またはNHを表し、R'はアゾール環を形成できる三価の芳香族基を示す。)

【0012】上記一般式1で示す本発明のホスホン酸含有ポリアゾール化合物を合成する経路は特に限定され

ないが、通常は式中Rで示すアゾール環を形成できる4価の芳香族基単位を形成する芳香族ジアミンジオール、芳香族ジアミンジチオール、芳香族テトラミンおよびそれらの誘導体から選ばれる化合物と、R'で示す二価基を形成するジカルボン酸およびその誘導体から選ばれる化合物の反応により合成することができる。その際、使用するジカルボン酸の中にホスホン酸を含有するジカルボン酸を使用することで、得られるポリアゾール中にホスホン酸基を導入することができる。

【0013】芳香族ジアミンジオール、芳香族ジアミンジチオール、芳香族テトラミンの具体例としては、2,5-ジヒドロキシパラフェニレンジアミン、4,6-ジヒドロキシメタフェニレンジアミン、2,5-ジアミノ-1,4-ベンゼンジチオール、4,6-ジアミノ-1,3-ベンゼンジチオール、2,5-ジアミノ-3,6-ジメチル-1,4-ベンゼンジチオール、1,2,4,6-テトラアミノベンゼン、3,3'-ジヒドロキシベンジジン、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジフェニルベンゼンジオール、3,3'-ジジメルカプトベンジジン、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジフェニルベンゼンジチオール、3,3'-ジアミノベンジジン、ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)エーテル、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)エーテル、ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェニル)エーテル、ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェニルフェニル)エーテル、3,3',4,4'-テトラアミノジフェニルエーテル、ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェニル)スルホン、ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェニルフェニル)スルホン、3,3',4,4'-テトラアミノジフェニルスルホン、2,2-ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェニルフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,4-ジアミノフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェニルフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3,4-ジアミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-アミノ-3-ヒドロキシフェノキシ)ベンゼン、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェノキシ)ベンゼン、ビス(4-アミノ-3-メルカプトフェノキシ)ベンゼン、ビス(3-アミノ-4-メルカプトフェノキシ)ベンゼン、ビス(3,4-ジアミノ

フェノキシ)ベンゼン等が挙げられるがこれらに限定されることはない。また、これらの化合物を同時に複数使用することもできる。これらの芳香族ジアミンジオール、芳香族ジアミンジチオールは、必要に応じて塩酸、硫酸、リン酸などの酸との塩でもあってもよく、塩化すず(II)や亜リン酸化合物など公知の酸化防止剤を含んでいてもよい。

【0014】ホスホン酸含有ジカルボン酸の具体例としては、例えば、2, 5-ジカルボキシフェニルホスホン酸、3, 5-ジカルボキシフェニルホスホン酸、2, 5-ビスホスホノテレフタル酸、などのホスホン酸含有ジカルボン酸及びこれらの誘導体を挙げることができるが、これらに限定されることはない。ホスホン酸含有ジカルボン酸はそれら単独だけでなく、ホスホン酸を含有しないジカルボン酸とともに共重合の形で導入することができる。ホスホン酸含有ジカルボン酸とともに使用できるジカルボン酸例としては、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、ジフェニルスルホンジカルボン酸、ビフェニルジカルボン酸、ターフェニルジカルボン酸、2, 2-ビス(4-カルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン等ポリエステル原料として報告されている一般的なジカルボン酸を使用することができ、ここで例示したものに限定されるものではない。ホスホン酸含有ジカルボン酸とともにホスホン酸を含有しないジカルボン酸を使用する場合、ホスホン酸の効果を明確にするために、ホスホン酸含有ジカルボン酸は全ジカルボン酸中の20モル%以上であることが好ましいが、際だった効果を引き出すために50モル%以上であることがさらに好ましい。ホスホン酸基を含有するジカルボン酸の純度は特に制限されるものではないが、97%以上が好ましく、98%以上がより好ましい。ホスホン酸基を含有するジカルボン酸を原料として重合されたポリアゾールは、ホスホン酸基を含有しないジカルボン酸を用いた場合に比べて、重合度が低くなる傾向が見られるため、ホスホン酸基を含有するジカルボン酸はできるだけ純度が高いものを用いることが好ましい。

【0015】上記一般式2で示すポリアゾール単位を導入する経路は特に限定されないが、通常は式中Rで示すアゾール環を形成できる三価の芳香族基単位を形成するオルト位にアミノ基を2個持つ芳香族カルボン酸、オルト位の関係でアミノ基とヒドロキシル基を持つ芳香族カルボン酸、オルト位の関係でアミノ基とメルカプト基を持つ芳香族カルボン酸およびそれらの誘導体から選ばれる化合物の重合により得ることができる。

【0016】これらのホスホン酸含有ポリアゾールを合成する手法は、特に限定されないが、J.F. Wolfe, Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, 2nd Ed., Vol. 11, P. 601 (1988)に記載されるようなポリリン酸を溶媒とする脱水、環化重合により合成することがで

きる。また、ポリリン酸のかわりにメタンスルホン酸/五酸化リン混合溶媒系もちいた同様の機構による重合を適用することもできる。他に、適当な有機溶媒中や混合モノマー融体の反応でポリアミド構造などの前駆体ポリマーとしておき、その後の適当な熱処理などによる環化反応で目的のポリアゾール構造に変換する方法なども使用することができる。熱安定性の高いポリマーを合成するには、一般によく使用されるポリリン酸を用いた重合が好ましい。しかしながら、従来報告されているような長時間をかけた重合では、ホスホン酸含有モノマーを含む系では、得られたポリマーの熱安定性が低下してしまう恐れがある。このため、本発明では、重合時間は個々のモノマーの組み合わせにより最適な時間があるので一概には規定できないが、重合時間を効果的に短くすることが好ましい。このことにより、ホスホン酸基量が多いポリマーも熱安定性の高い状態で得ることができる。これらのホスホン酸基含有ポリアゾール化合物の分子量は特に限定されるものではないが、1,000~1,000,000であることが好ましい。低すぎると、良好な成形物を得ることが困難になる。また、繰り返し単位が複数の場合主としてランダムおよび/または交互的に結合していることで、高分子電解質膜として安定した性能を示す特徴を持つ。

【0017】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾール化合物は、重合溶液又は単離したポリマーから押し出し、紡糸、圧延、キャストなど任意の方法で繊維やフィルムに成形することができる。中でもNMPに溶解した溶液から成形することが好ましい。NMP以外にも溶解する溶媒としては、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチル-2-ピロリドン、ヘキサメチルホスホンアミドなど非プロトン極性溶媒や、ポリリン酸、メタンスルホン酸、硫酸、トリフルオロ酢酸などの強酸から適切なものを選ぶことができるがこれらに限定されるものではない。これらの溶媒は、可能な範囲で複数を混合して使用してもよい。また、溶解性を向上させる手段として、臭化リチウム、塩化リチウム、塩化アルミニウムなどのルイス酸を有機溶媒に添加したものを溶媒としてもよい。溶液中のポリマー濃度は0.1~30重量%の範囲であることが好ましい。低すぎると成形性が悪化し、高すぎると加工性が悪化する。

【0018】溶液から成形体を得る方法は公知の方法を用いることができる。例えば加熱、減圧乾燥、ポリマーを溶解する溶媒と混和できるポリマー非溶媒への浸漬などによって、溶媒を除去しスルホン酸基含有ポリアゾール化合物の成形体を得ることができる。溶媒が有機溶媒の場合は、加熱又は減圧乾燥で溶媒を留去させることが好ましい。溶媒が強酸の場合には、水、メタノール、アセトンなどに浸漬することが好ましい。この際、必要に応じて他のポリマーと複合された形で繊維やフィルムに

成型することもできる。溶解性挙動が類似するポリベンザゾール系ポリマーと組み合わせると、良好な成形をするのに都合がよい。

【0019】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾール化合物を主成分とする膜を成形する好ましい方法は、溶液からのキャストである。キャストした溶液から前記のように溶媒を除去してホスホン酸基含有ポリアゾール化合物の膜を得ることができる。溶媒の除去は、乾燥することが膜の均一性からは好ましい。また、ポリマーや溶媒の分解や変質をさけるため、減圧下でできるだけ低い温度で乾燥することが好ましい。キャストする基板には、ガラス板やテフロン（登録商標）板などを用いることができる。溶液の粘度が高い場合には、基板や溶液を加熱して高温でキャストすると溶液の粘度が低下して容易にキャストすることができる。キャストする際の溶液の厚みは特に制限されないが、10～1000 μm であることが好ましい。薄すぎると膜としての形態を保てなくなり、厚すぎると不均一な膜ができやすくなる。より好ましくは100～500 μm である。溶液のキャスト厚を制御する方法は公知の方法を用いることができる。例えば、アプリケーション、ドクターブレードなどを用いて一定の厚みにしたり、ガラスシャーレなどを用いてキャスト面積を一定にして溶液の量や濃度で厚みを制御することができる。キャストした溶液は、溶媒の除去速度を調整することでより均一な膜を得ることができる。例えば、加熱する場合には最初の段階では低温にして蒸発速度を下げたりすることができる。また、水などの非溶媒に浸漬する場合には、溶液を空気中や不活性ガス中に適当な時間放置しておくなどしてポリマーの凝固速度を調整することができる。本発明の膜は目的に応じて任意の膜厚にすることができるが、イオン伝導性の面からはできるだけ薄いことが好ましい。具体的には200 μm 以下であることが好ましく、50 μm 以下であることがさらに好ましく、20 μm 以下であることが最も好ましい。

【0020】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾールポリマーはイオン伝導性に優れているため、フィルム、膜状にして燃料電池などのイオン交換膜として使用するのに適している。さらに、本発明のポリマー構造を主成分にすることにより、本発明のイオン交換膜と電極との接合体を作製するときのバインダー樹脂として利用することもできる。

【0021】本発明のホスホン酸含有ポリアゾールポリマー化合物は、測定の方法は後に述べるがTGA測定における200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400℃以上であることを特徴としているが、好ましくは同条件で測定した3%重量減少温度が420℃以上である。さらに好ましくは同条件で測定した3%重量減少温度が450℃以上である。仮に、これまで述べてきたようなホスホン酸基を含むポ

リアゾール構造に含まれるものであっても、TGA測定における200℃昇温時点の試料重量を基準にしたときの3%重量減少温度が400℃未満しか示さないものでは、高温時における耐久安定性が本発明のポリマーに比べて劣るので本発明の目的を達成することはできない。

【0022】本発明のホスホン酸基含有ポリアゾールポリマーはNMPに5wt%以上で溶解することも特徴としている。ポリアゾール系ポリマーは一般に溶解性が低く、強酸性溶媒にしか溶解しない場合も多い。高分子電解質膜を作る場合、強酸性溶液からの湿式法で膜を作ると、膜構造が不均一になりやすく、安定した性能を維持する膜を作ることが難しい。一方、本発明のようにNMPを始めとする有機溶媒に可溶性のポリマーは、乾式法で製膜することができ、均質で、長期にわたり安定した膜性能を示す高分子電解質膜が作れる。このため、上で述べてきたようなホスホン酸基を含むポリアゾール構造に含まれるものであっても、NMPに5wt%以上で溶解しないものでは、本発明の目的を達成することはできない。

【0023】また、本発明による膜は、機械的特性に優れている。膜厚の薄い状態でも膜の取り扱いで破断などの心配がないものである。

【0024】

【実施例】以下本発明を実施例を用いて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されることはない。なお、各種測定は次のように行った。

TGA測定：TGA測定は島津製作所製TGA-50を用い、試料約5mgについてアルゴン雰囲気下で測定した。昇温は、10℃/分で100℃にした後30分100℃で保持して試料中の水分を除去した後、10℃/分で600℃まで測定した。200℃昇温時点の試料重量を基準にその3%が減量した時点の温度を3%重量減少温度と定義する。

ポリマー対数粘度：溶媒として硫酸を用いてオストワルド粘度計を用いて測定した。0.5g/dlの硫酸溶液について30℃で測定した。

IR測定：分光器にBiorad社FTS-40、顕微鏡にBiorad社UM A-300Aを用いた顕微透過法により測定した。

【0025】実施例1

3, 3', 4, 4'-テトラアミノジフェニルスルホン（略号：TAS）1.830g(6.575 $\times 10^{-3}$ mole)、3, 5-ジカルボキシフェニルホスホン酸（略号：DCP、純度99%）1.084g(4.405 $\times 10^{-3}$ mole)、テレフタル酸（略号：TPA）0.359g(2.170 $\times 10^{-3}$ mole)ポリリン酸（五酸化リン含量75%）20.48g、五酸化リン16.41gを重合容器に量り取る。窒素を流し、オイルバス上ゆっくり攪拌しながら100℃まで昇温する。100℃で1時間保持した後、145℃に昇温して1時間、220℃に昇温して5時間重合した。重合終了後放冷し、水を加えて重合物を取り出し、家庭用ミキサーを用いてpH試験紙中性に

なるまで水洗を繰り返した。得られたポリマーは80℃で終夜減圧乾燥した。ポリマーの対数粘度は、1.13を示した。得られたポリマー300mgとNMP3mlを攪拌しながら、オイルバス上で170℃に加熱して溶解させた。ホットプレート上で、ガラス板上に約225μm厚に流延し、NMPを蒸発させた。フィルムをガラス板からはがし、80℃終夜減圧乾燥し、その後アセトン浸漬することで溶媒を除いてフィルムを作製した。得られたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減少温度は444℃であった。ポリマーのIRスペクトルを図1に示す。

【0026】実施例2

実施例1において、ジカルボン酸成分としてDCPとTPAの混合比を34:66(モル比)に変えて、合計で(6.575x10⁻³mole)になるようにして仕込む以外は、実施例1と同様にして重合および各種測定を行った。ポリマーの対数粘度は0.99、3%重量減少温度は425℃であった。

【0027】比較例1

3,3'-ジヒドロキシベンジジン(略号:HAB)1.860g(8.602x10⁻³mole)、2,5-ジカルボキシベンゼンスルホン酸モノナトリウム(略号:STA)2.307g(8.602x10⁻³mole)、ポリリン酸(五酸化リン含量75%)24.98g、五酸化リン20.02gを重合容器に量り取る。窒素を流し、オイルバス上ゆっくり攪拌しながら98℃まで昇温する。98℃で1時間保持した後、150℃に昇温して1時間、200℃に昇温して4.5時間重合した。重合終了後放冷し、水を加えて重合物を取り出し、家庭用ミキサーを用いてpH試験紙中性になるまで水洗を繰り返した。

得られたポリマーは80℃で終夜減圧乾燥した。ポリマーの対数粘度は、1.02を示した。合成したポリマー試料0.12gにメタンスルホン酸1.8gを加えて、数時間マグネティックスターラーで攪拌して溶解し、ポリ〔(ベンゾ[1,2-d:5,4-d']ビスオキサゾール-2,6-ジイル)-1,4-フェニレン〕の1wt%メタンスルホン酸ドープ(固有粘度=24dl/g)を3g加えて、さらに数時間攪拌し均一溶液とした。ホットプレート上でガラス板上に約225μm厚に流延し、1時間室温で放置した後、水中にガラス板を浸した。水を時々交換し、数日水浸漬を続ける。フィルムを取り出し、周りを固定して収縮を押さえながら風乾した。最後に減圧乾燥機により80℃終夜乾燥することでフィルムを作製した。得られたフィルムのTGA測定を行うと3%重量減少温度は396℃であった。

【0028】比較例2

実施例1において、ジカルボン酸成分をDCP6.575x10⁻³moleにして仕込む以外は、実施例1と同様にして重合を行った。ポリマーの対数粘度は1.06であった。得られたポリマー300mgとNMP3mlを攪拌しながら、オイルバス上で170℃に加熱して溶解を試みたが、溶解せず製膜できなかった。

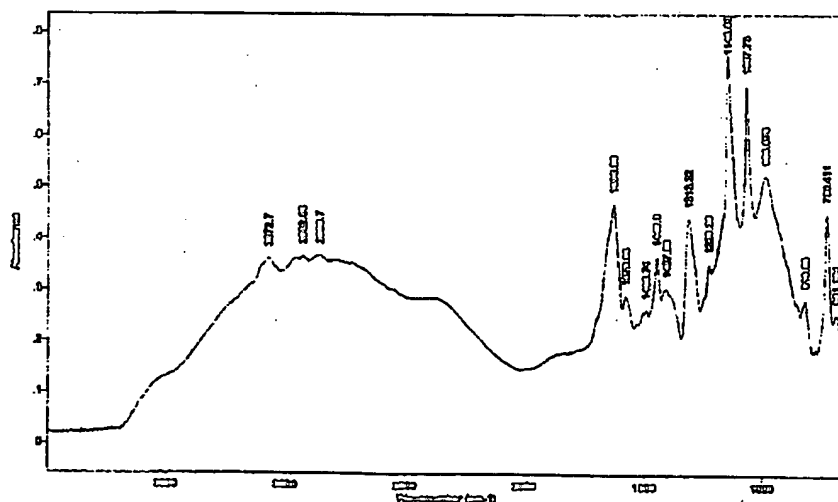
【0029】

【発明の効果】本発明のポリマーにより、耐熱性に優れ、燃料電池などの高分子電解質としても際立った耐久性を示す材料を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】TAS、DCP及びTPAから合成されたホスホン酸含有ポリベンズイミダゾールのIRスペクトル

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

F I

テーマコード (参考)

C O 8 L 79:04

C O 8 L 79:04

(72) 発明者 高瀬 敏

滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 濱本 史朗

滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 館盛 寛

滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

F ターム (参考) 4F071 AA60 AA81 AA83 AF02 AF05

AF05Y AF13 AF37 AF45

AF45Y AH15 BA02 BB02

BC01

4J043 PA02 PA08 PA10 QB34 QB35

QB41 RA42 RA52 RA57 SA06

SA08 SA71 SA83 SB01 SB03

TA12 TA79 TB01 TB03 UA121

UA122 UA131 UA132 UA142

UB021 UB061 UB062 UB121

UB122 UB301 UB302 VA011

VA012 VA041 VA042 VA051

VA052 VA081 VA082 XA03

XA19 ZA12 ZA15 ZA17 ZA31

ZB14

5G301 CA30 CD01 CE01 CE10

5H026 AA06 CX04 EE18 HH00